

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第3984183号  
(P3984183)

(45) 発行日 平成19年10月3日(2007.10.3)

(24) 登録日 平成19年7月13日(2007.7.13)

(51) Int.C1.

F 1

<b>H05B 33/22</b>	<b>(2006.01)</b>	H05B 33/22	Z
<b>H05B 33/12</b>	<b>(2006.01)</b>	H05B 33/12	B
<b>H01L 51/50</b>	<b>(2006.01)</b>	H05B 33/14	A

請求項の数 7 (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2003-78112 (P2003-78112)  
 (22) 出願日 平成15年3月20日 (2003.3.20)  
 (65) 公開番号 特開2004-288447 (P2004-288447A)  
 (43) 公開日 平成16年10月14日 (2004.10.14)  
 審査請求日 平成16年9月17日 (2004.9.17)

(73) 特許権者 502356528  
 株式会社 日立ディスプレイズ  
 千葉県茂原市早野3300番地  
 (74) 代理人 100083552  
 弁理士 秋田 収喜  
 (72) 発明者 伊藤 雅人  
 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社  
 日立ディスプレイズ内  
 (72) 発明者 安川 晶子  
 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社  
 日立ディスプレイズ内  
 審査官 松田 肇之

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機EL表示装置

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

基板上に画素領域ごとに形成された透光性の導電膜と、発光材料層と、各画素領域に共通な対向電極と、前記導電膜上に開口を備えたバンク膜を有し、

前記バンク膜の側壁では発光材料層とバンク膜との間の側壁面に非導電性である金属酸化物で構成された光反射機能が施されていることを特徴とする有機EL表示装置。

## 【請求項2】

前記バンク膜の開口部の少なくとも側壁面に金属酸化膜が被着されていることを特徴とする請求項1に記載の有機EL表示装置。

## 【請求項3】

前記バンク膜にはそれ自体の光透過率を低減させる顔料が含有されていることを特徴とする請求項1に記載の有機EL表示装置。

## 【請求項4】

基板上に画素領域ごとに形成された透光性の導電膜と、発光材料層と、各画素領域に共通な対向電極と、前記導電膜上に開口を備えたバンク膜を有し、

前記バンク膜の開口の側壁では発光材料層とバンク膜との間の側壁面に、光屈折率が前記バンク膜の材料の光屈折率と異なる絶縁性の材料層を有することを特徴とする有機EL表示装置。

## 【請求項5】

前記材料層の光屈折率は前記バンク膜の光屈折率よりも大きいことを特徴とする請求項

4に記載の有機EL表示装置。

【請求項6】

前記バンク膜の下に、前記透光性の導電膜に接続されている薄膜トランジスタを有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の有機EL表示装置。

【請求項7】

前記バンク膜の下に、  
表示領域の第1方向に延在し、第1方向と交差する第2方向に並設されたゲート配線と、  
表示領域の第2方向に延在し、第2方向と交差する第1方向に並設されたドレイン配線と、

10

前記ゲート配線と前記ドレイン配線とに接続されている薄膜トランジスタと、  
を有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の有機EL表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は有機EL表示装置に係り、その各画素領域がその画素領域と隣接する他の画素領域とバンク膜によって仕切られている有機EL表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

たとえば、アクティブ・マトリクス型の有機EL表示装置は、その基板の表面において、  
x方向に延在されy方向に並設されるゲート信号線と、y方向に延在されx方向に並設さ  
れるドレイン信号線とを有し、これら各信号線によって囲まれた矩形状の領域を画素領域  
とする。

20

【0003】

これら各画素領域には、片側のゲート信号線からの走査信号によってオンするスイッチング  
素子と、このスイッチング素子を介して片側のドレイン信号線からの映像信号が供給さ  
れる画素電極を有する。

【0004】

そして、この画素電極の上面には発光材料層を介して対向電極が積層されるようになって  
いる。この対向電極は前記映像信号に対して基準となる信号が供給されるようになってい  
る。

30

【0005】

発光材料層には前記各電極を介して電流が流れ、この電流に応じて該発光材料層に発光が  
なされ、前記各電極のうち一方の電極（透光性の導電膜）を通して該発光を認識できるよ  
うに構成されている。

【0006】

ここで、前記信号線および電極等はフォトリソグラフィ技術による選択エッチングにより  
形成されるが、発光材料層はいわゆる蒸着シャドウマスクを用いて形成されるのが通常で  
ある。発光材料層は水分等を含むと変質する等の性質を有するからである。

【0007】

40

そして、該発光材料層が基板上に被着される段階では液体状となっているため、各画素領域  
をその画素領域と隣接する他の画素領域に対して仕切るためのたとえば樹脂からなるバ  
ンク膜を予め形成しておき、このバンク膜の開口部内に充填させるようにしている（特許  
文献1参照）。

【0008】

【特許文献1】

特開2000-176660号公報

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

このように構成された有機EL表示装置は、その画素領域を小さくする一方において、光

50

の取り出し効率を向上させることが強く望まれている。

【0010】

しかし、上述のように、各画素領域を仕切るバンク膜が形成されている場合、発光材料層からの光の一部が該バンク膜中に入射され、この光は画素の輝度の向上において有効に利用されないため、その改善策を思索した。

【0011】

本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、光の取り出し効率の良好な有機EL表示装置を提供するにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0013】

手段1.

本発明による有機EL表示装置は、たとえば、基板の表面の画素領域に、一方の電極、発光材料層、および他方の電極が少なくとも積層され、

前記発光材料層は、当該画素領域と隣接する他の画素領域とを仕切るバンク膜の開口部内に充填されて形成されているとともに、

該バンク膜の開口部の少なくとも側壁面に光反射機能が施されていることを特徴とするものである。

【0014】

手段2.

本発明による有機EL表示装置は、たとえば、基板の表面の画素領域に、一方の電極、発光材料層、および他方の電極が少なくとも積層され、

前記発光材料層は、当該画素領域と隣接する他の画素領域とを仕切るバンク膜の開口部内に充填されて形成されているとともに、

該バンク膜の開口部の少なくとも側壁面に該バンク膜の材料の光屈折率と異なる光屈折率の材料層が形成されていることを特徴とするものである。

【0015】

手段3.

本発明による有機EL表示装置は、たとえば、手段2の構成を前提とし、前記バンク膜の材料の光屈折率と異なる光屈折率の前記材料層はその光屈折率が該バンク膜のそれよりも大きいことを特徴とするものである。

【0016】

手段4.

本発明による有機EL表示装置は、たとえば、基板の表面の画素領域に、一方の電極、発光材料層、および他方の電極が少なくとも積層され、

前記発光材料層は、当該画素領域と隣接する他の画素領域とを仕切るバンク膜の開口部内に充填されて形成され、

該バンク膜の開口部の少なくとも側壁面に光反射機能が施されているとともに、該バンク膜にはそれ自体の光透過率を低減させる顔料が含有されていることを特徴とするものである。

【0017】

手段5.

本発明による有機EL表示装置は、たとえば、手段1の構成を前提とし、前記バンク膜の開口部の少なくとも側壁面に金属酸化膜が被着されていることを特徴とするものである。

【0018】

なお、本発明は以上の構成に限定されず、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

【0019】

10

20

30

40

50

**【発明の実施の形態】**

以下、本発明による液晶表示装置の実施例を図面を用いて説明をする。

**【0020】**

実施例1.

**《表示部の等価回路》**

図2は、本発明による有機EL表示装置の表示領域の一実施例を示す等価回路図である。

**【0021】**

同図において、まず図中x方向に延在しy方向に並設されるゲート信号線GLが形成され、また、y方向に延在しx方向に並設されるドレイン信号線DLが形成されている。

**【0022】**

これらゲート信号線GLとドレイン信号線DLとで囲まれる矩形状の領域は画素領域となり、これら画素領域の集合体は表示領域を構成するようになっている。

**【0023】**

各画素領域には、片側(図中上側)のゲート信号線GLからの走査信号によりオンされる薄膜トランジスタTFTと、この薄膜トランジスタTFTを介して片側(図中左側)のドレイン信号線DLからの映像信号が供給される画素電極PXとを備えている。

**【0024】**

この画素電極PXは図示しない対向電極とで発光材料層を挟持するように構成され、該画素電極PXと対向電極との間に流れる電流に応じて該発光材料層が発光されるようになっている。

**【0025】**

ここで、対向電極は各画素領域に共通に形成され、前記映像信号に対して基準となる信号が供給されるようになっている。

**【0026】**

このような構成において、前記各ゲート信号線GLには走査信号の供給によってその一つが順次選択され、その一方において、前記各ドレイン信号線DLのそれぞれに、前記ゲート信号線GLの選択のタイミングに合わせて映像信号が供給されるように駆動される。

**【0027】****《画素の構成》**

図3は前記画素領域の一実施例を示す平面図である。また、図3のI-I線における断面を図1に示している。

**【0028】**

図3において、たとえばガラスからなる基板SUB1(図1参照)の表面の各画素領域のたとえば左上の個所に図中x方向に延在するポリシリコン層からなる半導体層PSが形成されている。この半導体層PSは薄膜トランジスタTFTの半導体層となるものである。

**【0029】**

そして、この半導体層PSをも被って該基板SUB1の表面には絶縁膜GI(図1参照)が形成されている。この絶縁膜GIは薄膜トランジスタTFTの形成領域においてゲート絶縁膜として機能するものである。

**【0030】**

この絶縁膜GIの表面にはそのx方向に延在しy方向に並設されるゲート信号線GLが形成されている。このゲート信号線GLは後述のドレイン信号線DLとで前記画素領域を画するようにして形成される。

**【0031】**

また、このゲート信号線GLは、その一部において前記半導体層PSのほぼ中央部を横切るようにして延在される延在部が形成され、この延在部は薄膜トランジスタTFTのゲート電極GTとして機能するようになっている。

**【0032】**

なお、このゲート電極GTの形成後にはそれをマスクとして不純物イオンが打ち込まれ、該ゲート電極GTの直下以外の領域の前記半導体層PSの部分は低抵抗化されるようにな

10

20

20

30

40

50

っている。

**【0033】**

ゲート信号線 G L (ゲート電極 G T) をも被って前記基板 S U B 1 の表面には絶縁膜 I N (図 1 参照) が形成されている。この絶縁膜 I N は次に説明するドレイン信号線 D L の形成領域においてゲート信号線 G L に対する層間絶縁膜としての機能を有する。

**【0034】**

絶縁膜 I N の表面にはその y 方向に延在され x 方向に並設されるドレイン信号線 D L が形成されている。このドレイン信号線 D L の一部は前記半導体層 P S の一端部にまで延在され、絶縁膜 I N および絶縁膜 G I を貫通して予め形成されたスルーホール T H 1 を通して該半導体層 P S と接続されている。すなわち、ドレイン信号線 D L の前記延在部は薄膜トランジスタ TFT のドレイン電極 S D 1 として機能する。10

**【0035】**

また、前記半導体層 P S の他端部には絶縁膜 I N および絶縁膜 G I を貫通して予め形成されたスルーホール T H 2 を通して接続されたソース電極 S D 2 が形成され、このソース電極 S D 2 は後述の画素電極 P X と接続させるための延在部が形成されている。

**【0036】**

そして、このようにドレイン信号線 D L (ドレイン電極 S D 1)、ソース電極 S D 2 が形成された基板 S U B 1 の表面には絶縁膜 I L (図 1 参照) が形成されている。

**【0037】**

この絶縁膜 I L の上面には、各画素領域の僅かな周辺を除く中央に画素(陽極)電極 P X が形成され、この画素電極 P X は該絶縁膜 I L に形成したスルーホール T H 3 を通して前記薄膜トランジスタ TFT のソース電極 S D 2 と接続されている。なお、この画素電極 P X はたとえば ITO (Indium Tin Oxide) 等の透光性の導電膜で形成されている。後述する発光材料層 F L R からの光を基板 S U B 1 側へ透過させるためである。20

**【0038】**

画素電極 P X の上面には正孔輸送層 H T P を介して発光材料層 F L R が、さらには電子注入層 E P R が積層されて形成され、これら発光材料層 F L R を含む各層は隣接する他の画素領域の発光材料層等と有機材料層からなるバンク(隔壁)膜 B N K によって画されて形成されている。

**【0039】**

ここで、該バンク膜 B N K は、たとえば前記画素電極 P X を形成した後に形成され、透明基板 S U B 1 の上面の全域に塗布したたとえば樹脂膜等を前記画素電極 P X の周辺を除く中央の大部分を露出させる開口を設けるようにして形成されている。30

**【0040】**

さらに、このバンク膜 B N K は、その表面および前記開口の側壁面に該バンク膜 B N K の材料とは異なる材料であって比較的膜厚の小さな光反射膜 L R L が形成されている。この光反射膜 L R L は、それ自体光反射機能を有せず前記バンク膜 B N K の材料の屈折率 n<sub>1</sub> よりも小さな屈折率 n<sub>2</sub> を有する材料を選択して該バンク膜 B N K との界面で光反射を生じさせるようにしてもよく、また、それ自体光反射機能を有する材料を選択するようにしてもよい。40

**【0041】**

前者の場合、たとえば、バンク膜 B N K として、アクリル樹脂 (n<sub>1</sub> = 1.49 ~ 1.50) を用い、光反射膜 L R L として、ポリイミド (n<sub>2</sub> = 1.52 ~ 1.54)、ポリスチレン (n<sub>2</sub> = 1.59 ~ 1.50)、ポリカーボネート樹脂 (n<sub>2</sub> = 1.58 ~ 1.59)、フェノール樹脂 (n<sub>2</sub> = 1.58 ~ 1.66)、エポキシ樹脂 (n<sub>2</sub> = 1.55 ~ 1.61) を用いたものであってもよい。

**【0042】**

また、バンク膜 B N K として、メタクリル樹脂 (n<sub>1</sub> = 1.49) を用い、光反射膜 L R L として、ポリイミド (n<sub>2</sub> = 1.52 ~ 1.54)、ポリスチレン (n<sub>2</sub> = 1.59 ~ 1.50)、ポリカーボネート樹脂 (n<sub>2</sub> = 1.58 ~ 1.59)、フェノール樹脂 (n<sub>2</sub> = 1.55 ~ 1.61) を用いたものであってもよい。50

$n_2 = 1.58 \sim 1.66$ ）、エポキシ樹脂（ $n_2 = 1.55 \sim 1.61$ ）を用いたものであってもよい。

【0043】

また、バンク膜BNKとして、低屈折ポリイミドを用い、光反射膜LRLとして、高屈折ポリイミドを用いたものであってもよい。

【0044】

また、バンク膜BNKとして、フッ素樹脂（ $n_1 = 1.35$ ）を用い、光反射膜LRLとして、ポリイミド（ $n_2 = 1.52 \sim 1.54$ ）、ポリスチレン（ $n_2 = 1.59 \sim 1.60$ ）、ポリカーボネート樹脂（ $n_2 = 1.58 \sim 1.59$ ）、フェノール樹脂（ $n_2 = 1.58 \sim 1.66$ ）、エポキシ樹脂（ $n_2 = 1.55 \sim 1.61$ ）を用いたものであつてもよい。 10

【0045】

また、バンク膜BNKとして、シリコン樹脂（ $n_1 = 1.43$ ）を用い、光反射膜LRLとして、ポリイミド（ $n_2 = 1.52 \sim 1.54$ ）、ポリスチレン（ $n_2 = 1.59 \sim 1.60$ ）、ポリカーボネート樹脂（ $n_2 = 1.58 \sim 1.59$ ）、フェノール樹脂（ $n_2 = 1.58 \sim 1.66$ ）を用いたものであってもよい。

【0046】

また、バンク膜BNKとして、屈折率1.5未満の樹脂を用い、光反射膜LRLとして屈折率1.5以上の樹脂を用いたものであってもよい。

【0047】

また、バンク膜BNKとして、シリコン酸化膜（ $n_1 = 1.46$ ）を用い、光反射膜LRLとして、屈折率1.5以上の樹脂、窒化シリコンを用いたものであってもよい。 20

【0048】

さらに、後者の場合、バンク膜BNKとして、シリコン酸化膜（ $n_1 = 1.46$ ）を用い、光反射膜LRLとして、金属酸化物（ $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{HfO}_2$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 $\text{TiO}$ 、 $\text{Ta}_2\text{O}_5$ 、 $\text{CaO}$ 、 $\text{BaO}$ ）を用いたものであってもよい。

【0049】

また、バンク膜BNKとして、窒化シリコンを用い、光反射膜LRLとして、金属酸化物（ $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{HfO}_2$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 $\text{TiO}$ 、 $\text{Ta}_2\text{O}_5$ 、 $\text{CaO}$ 、 $\text{BaO}$ ）を用いたものであってもよい。 30

【0050】

なお、前記アクリル樹脂としては、オプトマーPCシリーズ（JSR社製）、東京応化のレジスト材料等、ポリイミド樹脂としては、OPI-Nシリーズ（日立化成）、フォトニースシリーズ（東レ）等、フェノール樹脂としては、WIX-2（日本ゼオン）、ポジ型レジスト（JSR、東京応化）等、フッ素樹脂としては、フッ素樹脂レジスト等、低屈折ポリイミドとしては、オプトレツツ（日立化成）等、高屈折ポリイミドとしては、OPI-Nシリーズ（日立化成）等を用いることができる。

【0051】

電子注入層EPRとバンク膜BNKの上面には各画素領域に共通な対向（陰極）電極CTが形成され、この対向電極CTの上面には高分子樹脂シールPSLを介してたとえばガラスからなる基板SUB2が貼り合わされている。 40

【0052】

画素電極PXと対向電極CTの間に介在された発光材料層FLRに電流が流れることによって、該発光材料層FLRが発光し、この光LTは画素電極PX、基板SUB1を介して目視することができる。

【0053】

なお、前記対向電極CTには映像信号に対して基準となる電圧信号が印加され、該映像信号はドレイン信号線DLから前記薄膜トランジスタTFTを介して前記画素電極PXに印加されるようになっている。また、該薄膜トランジスタTFTはゲート信号線GLからの走査信号によってスイッチオンされるようになっている。 50

## 【0054】

## 《効果》

上述した有機EL表示装置は、そのバンク膜BNKにおいて、その開口部の側壁面に光反射機能が施されているため、発光材料層FLRからの光が該開口部を通して出射する際に、たとえその側壁面側に入射する光があっても、その大部分が該側壁面で反射されることになり、この反射光は他の光と同様に観察者側に到ることができる。

## 【0055】

のことから、発光材料層FLRからの光は無駄なく観察者側に照射され、光の取り出しの効率を向上させることができる。

## 【0056】

また、上述した理由により、バンク膜BNKに入射される光がたとえあってもその量は少なく、したがって該バンク膜BNKを透過した光が隣接する他の画素領域に至るということがなくなる。すなわち、各画素における映像信号に対応する光の出射量が隣接する画素からのバンク膜BNKを通した光によって変化してしまうという弊害を回避でき、各画素の色純度を向上させることができる。

## 【0057】

## 実施例2.

図4は、本発明による有機EL表示装置の画素の他の実施例を示す構成図で、図1に対応した図となっている。

## 【0058】

図1の場合は、発光材料層FLRからの光を画素電極PXおよび基板SUB1側から取り出すようにして構成している。しかし、図4の場合は、発光材料層FLRからの光を対向電極CTおよび基板SUB2側から取り出すように構成したものである。このため、図4の場合は、少なくとも対向電極CTはたとえばITO(Indium Tin Oxide)等の透光性の導電膜で構成され、また、基板SUB2はガラス等の透明基板から構成されるようになっている。

## 【0059】

この場合においても、発光材料層FLR等を仕切るバンク膜BNKは、その表面およびその開口部の側壁面において、実施例2に示したと同様な光反射膜LRLが形成され、この膜自体あるいはバンク膜BNKとともに光反射機能を有するようになっている。

## 【0060】

## 実施例3.

上述した実施例では、バンク膜BNKの材料としてたとえば実施例1に示したもののが選択されるが、それらの材料中に光透過率を積極的に低減させる顔料、たとえば黒の顔料等を含有せることによってよいことはいうまでもない。

## 【0061】

このようにした場合、発光材料層FLRからの光がバンク膜BNKに僅かながら入射されるようなことがあっても、その光は該バンク膜BNK中に吸収され、隣接する他の画素領域に至ることを皆無にすることができる。各画素の映像信号に対応する光の出射量が隣接する画素からのバンク膜BNKを通した光によって影響を受けることなく、各画素の色純度を向上させるためである。

## 【0062】

## 実施例4.

上述した実施例では、光反射膜LRLはバンク膜BNKの開口の側壁面および表面に形成した構成としたものである。しかし、これに限定されることはなく、バンク膜BNKの開口の側壁面のみに形成するようにしてもよいことはいうまでもない。発光材料層FLRからの光がバンク膜BNK膜中に入射する場合、その光のうち該バンク膜BNKの開口の側壁面から入射する光が大部分であるからである。

## 【0063】

## 実施例5.

10

20

30

40

50

上述した実施例では、バンク膜BNKの上面には光反射膜LRLを形成したものであるが、これに限定されることはなく、光吸収膜を形成するようにしてもよい。この光吸収膜は発光材料層FLRからの光を該光吸収膜により吸収させるもので、たとえば黒等の顔料を含んだ膜として構成することができる。

#### 【0064】

のことから、バンク膜BNKそれ自体に光吸収の機能をもたせる場合、該光吸収膜を形成しない構成も考えられる。

#### 【0065】

上述した各実施例はそれぞれ単独に、あるいは組み合わせて用いても良い。それぞれの実施例での効果を単独あるいは相乗して奏することができるからである。

10

#### 【0066】

#### 【発明の効果】

以上説明したことから明らかなように、本発明による有機EL表示装置によれば、光の取り出し効率を向上させることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による有機EL表示装置の一実施例を示す構成図で、図3のI-I線における断面図である。

【図2】本発明による有機EL表示装置の表示部の一実施例を示す等価回路図である。

【図3】本発明による有機EL表示装置の画素の一実施例を示す平面図である。

【図4】本発明による有機EL表示装置の他の実施例を示す断面図である。

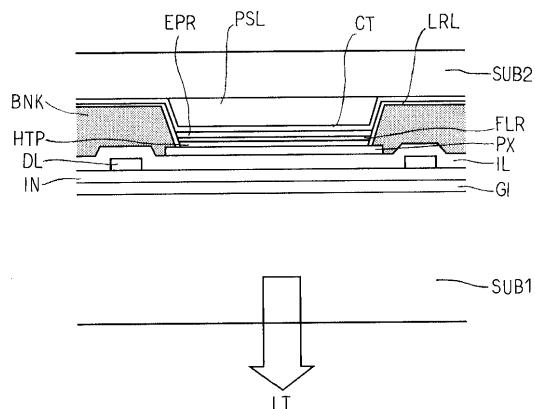
20

#### 【符号の説明】

SUB1, SUB2...基板、GL...ゲート信号線、DL...ドレイン信号線、TFT...薄膜トランジスタ、PX...画素電極、CT...対向電極、BNK...バンク膜、LRL...光反射膜

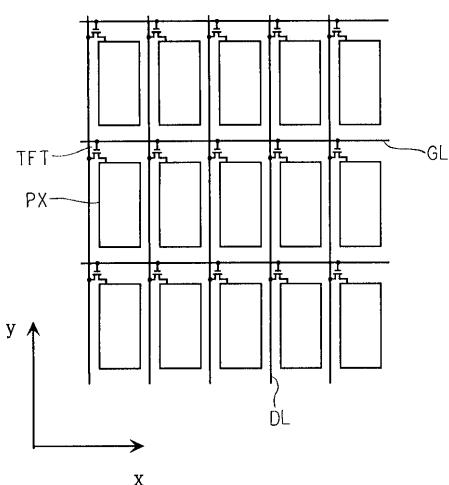
【図1】

図1



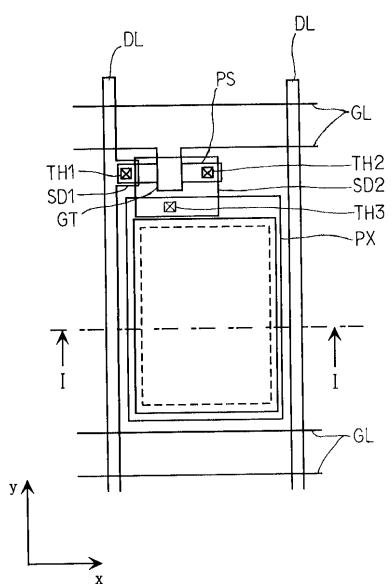
【図2】

図2



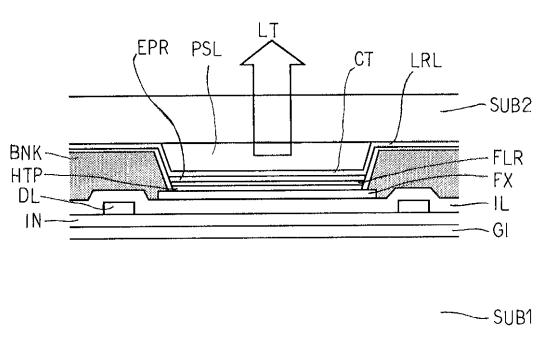
【図3】

図3



【図4】

図4



---

フロントページの続き

(56)参考文献 特開2004-199952(JP,A)  
特表2001-507503(JP,A)  
特開平05-089959(JP,A)  
特開2002-325955(JP,A)  
特開2002-208491(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H05B 33/10-33/28

H01L 51/00-51/56

H01L 27/32

专利名称(译)	有机EL表示装置		
公开(公告)号	<a href="#">JP3984183B2</a>	公开(公告)日	2007-10-03
申请号	JP2003078112	申请日	2003-03-20
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	日立显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	日立显示器有限公司		
[标]发明人	伊藤雅人 安川晶子		
发明人	伊藤 雅人 安川 晶子		
IPC分类号	H05B33/22 H05B33/12 H01L51/50 H01L27/32 H01L51/52 H05B33/00 H05B33/14		
CPC分类号	H01L27/3246 H01L51/5271 H01L51/5284		
FI分类号	H05B33/22.Z H05B33/12.B H05B33/14.A H01L27/32		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB03 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/FA01 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC05 3K107/DD89 3K107/EE33		
审查员(译)	松田敬之		
其他公开文献	<a href="#">JP2004288447A</a>		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

### 摘要(译)

提供一种具有改善的光提取效率的有机EL显示装置。一种有机电致发光器件，包括至少第一电极，发光材料层和堆叠在基板表面上的像素区域中的第二电极，其中，发光材料层形成为填充在堤膜的开口部分中，该堤膜将像素区域与与其相邻的另一像素区域分隔开，光反射功能被施加到堤膜的开口部分的侧壁表面。点域1

图 2

